

李静 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

任殿胜 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

李光平 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

严如岳 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

汝琼娜 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

董颜辉 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

摘要: 本文用RPM2050型快速扫描光荧光光谱仪(PL Mapper)研究经过Na<sub>2</sub>S·9H<sub>2</sub>O醇饱和溶液钝化处理后GaAs表面的光荧光特性。结果表明, GaAs表面经过硫钝化处理后, 可大大降低复合速度改善发光效率。

关键词:

文章全文为PDF格式, 请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器, 请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

### Study of photoluminescence character on GaAs surface passivated by Na<sub>2</sub>S

---

300192

300192

300192

300192

300192

300192

Abstract: Rapid Photoluminescence Mapper Was used to investigate luminescence efficiency of the GaAs surface, which was passivated using Na<sub>2</sub>S·9H<sub>2</sub>O alcohol solutions. It was found that the surface recombination rate of GaAs was reduced and the luminescence efficiency was improved by sulphide passivation.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]